

## 国内会議

1. 赤坂哲也, 中田真佐美, 石原俊一, 白井 肇, 半那純一, 清水 勇, “フッ素系原料を用いた多結晶シリコン薄膜形成過程のエリプソメトリーによる「その場」観察”, 1992 年春季第 39 回応用物理学関連連合講演会, 28a-ZV-5.
2. 石原俊一, He Deyan, 中田真佐美, 赤坂哲也, 白井 肇, 清水 勇, “非晶質基板上の微結晶シリコンの堆積(III)”, 1992 年春季第 39 回応用物理学関連連合講演会, 28a-ZV-4.
3. 赤坂哲也, 中田真佐美, 荒木雄三, 石原俊一, 白井 肇, 清水 勇, “フッ素系原料を用いた多結晶シリコン薄膜形成過程のエリプソメトリーによる「その場」観察 2”, 1992 年秋季第 53 回応用物理学会学術講演会, 19a-B-3.
4. 石原俊一, He Deyan, 赤坂哲也, 中田真佐美, 白井 肇, 清水 勇, “非晶質基板上の微結晶シリコンの堆積(IV)”, 1992 年秋季第 53 回応用物理学会学術講演会, 19a-B-8.
5. 赤坂哲也, 荒木雄三, 清水 勇, “フッ素系原料を用いた多結晶シリコン薄膜形成過程のエリプソメトリーによる「その場」観察 3”, 1993 年春季第 40 回応用物理学関連連合講演会, 31a-ZF-6.
6. 荒木雄三, 赤坂哲也, 清水 勇, “多結晶シリコン薄膜形成過程のエリプソメトリー「その場」観察及び断面 TEM 観察”, 1993 年春季第 40 回応用物理学関連連合講演会, 31a-ZF-5.
7. 赤坂哲也, 中田真佐美, 石原俊一, 白井 肇, 半那純一, 清水 勇, “フッ素系原料を用いた多結晶シリコン薄膜形成過程のエリプソメトリーによる「その場」観察”, 平成 4 年度日本印刷学会第 88 回春季研究発表会, 東京工業大学, (1992).
8. 赤坂哲也, 清水 勇, “レイヤーバイレイヤー法によるシリコンネットワーク制御”, 第 6 回プラズマ材料シンポジウム, 東京大学山上会館, (1993).
9. 赤坂哲也, 荒木雄三, He Deyan, 清水 勇, “ガラス基板上的多結晶シリコン薄膜形成過程の「その場」観察”, 1993 年秋季第 54 回応用物理学会学術講演会, 29p-L-3.
10. 赤坂哲也, 田中康雄, 清水 勇, “ガラス基板上的多結晶シリコン薄膜低温形成過程の分光エリプソメトリーによる「その場」観察 2”, 1994 年春季第 41 回応用物理学関連連合講演会, 30a-ZA-9.
11. 武岡伸也, 横井崇行, 東 正信, 赤坂哲也, 白井 肇, 清水 勇, “ECR 法による Si 網目構造形成過程 V-不純物およびボイド形成”, 1994 年春季第 41 回応用物理学関連連合講演会, 30p-ZA-8.
12. 赤坂哲也, 清水 勇, “大面積デバイス用多結晶シリコン薄膜の作製とその分光エリプソメトリーによる「その場」観察”, 平成 6 年度日本印刷学会第 92 回春季研究発表会, 東京工業大学, (1994).
13. 赤坂哲也, 田中康雄, 清水 勇, “ガラス基板上的多結晶シリコン薄膜低温形成過程の分光エリプソメトリーによる「その場」観察(III)”, 1994 年秋季第 55 回応用物理学会学術講演会, 22a-ZH-5. 予稿集 No.2, pp. 783.
14. 赤坂哲也, 清水 勇, “多結晶シリコン薄膜低温形成過程の分光エリプソメトリーによるその場観察: 原子状水素による結晶化過程の解明”, 電子情報通信学会 シリコン材料・デバイス研究会, (1994).
15. 赤坂哲也, 田中康雄, 清水 勇, “多結晶シリコン薄膜低温形成過程の分光エリプソメト

- リーによる「その場」観察” 1995 年春季第 42 回応用物理学関連連合講演会, 30a-L-3. 予稿集 No.2, pp. 864.
16. 田中康雄, 赤坂哲也, 清水 勇, “多結晶シリコン薄膜低温形成過程の分光エリプソメトリーによる「その場」観察 II” 1995 年春季第 42 回応用物理学関連連合講演会, 30a-L-4. 予稿集 No.2, pp. 864.
  17. 赤坂哲也, 小林康之, 安藤精後, 小林直樹, “平坦な垂直ファセットを持つ GaN 微小六角柱構造の MOVPE による選択成長”, 1997 年春季第 44 回応用物理学関連連合講演会, 29p-K-4.
  18. 赤坂哲也, 小林康之, 安藤精後, 小林直樹, “選択成長 MOVPE による GaN 微小ファセットの形状制御”, 1997 年秋季第 58 回応用物理学学会学術講演会, 2p-Q-17.
  19. 赤坂哲也, 小林康之, 安藤精後, 小林直樹, 熊谷雅美, “GaN/Al<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>N ヘテロ構造を有する微小六角柱の MOVPE 選択成長”, 1997 年秋季第 58 回応用物理学学会学術講演会, 2p-Q-18.
  20. 小林康之, 赤坂哲也, 小林直樹, “SPA 法による MOVPE GaN 成長中の表面ストイキオメトリに及ぼすキャリアガスの影響”, 1997 年秋季第 58 回応用物理学学会学術講演会, 3a-Q-4.
  21. 赤坂哲也, 安藤精後, 小林康之, 熊谷雅美, 小林直樹, “GaN の選択成長と微小ファセットレーザへの応用”, 電子情報通信学会 レーザ量子エレクトロニクス研究会, 東京, (1998).
  22. 赤坂哲也, 西田敏夫, 安藤精後, 小林直樹, “選択成長 MOVPE による GaN 表面の平坦化”, 1998 年春季第 45 回応用物理学関連連合講演会, 28a-ZS-4.
  23. 西田敏夫, 赤坂哲也, 熊谷雅美, 安藤弘明, 小林直樹, “GaN の step-flow 成長と量子井戸構造の作製”, 1998 年春季第 45 回応用物理学関連連合講演会, 28a-ZS-2.
  24. 赤坂哲也, 安藤精後, 熊谷雅美, 松岡隆志, 小林直樹, “MOVPE 選択成長 GaN 六角柱の電流注入発光”, 1999 年春季第 46 回応用物理学関連連合講演会, 31a-N-10. 予稿集 No. 1, pp. 430.
  25. 赤坂哲也, 安藤精後, 小林直樹, “MOVPE 選択成長により作製した n-InGaN/p-GaN 六角柱からのエレクトロルミネッセンス”, 2000 年秋季第 61 回応用物理学学会学術講演会, 7p-L-7. 予稿集 No. 1, pp. 326.
  26. 赤坂哲也, 安藤精後, 西田敏夫, 斎藤久夫, 小林直樹, “SiC 段差基板を用いたクラックフリーGaIn厚膜の選択成長”, 2001 年春季第 48 回応用物理学関連連合講演会, 30p-L-6. 予稿集 No. 1, pp. 396.
  27. 赤坂哲也, 安藤精後, 西田敏夫, 斎藤久夫, 小林直樹, “InGaIn MQW 六角柱マイクロファセットレーザの室温電流注入発振”, 2001 年秋季第 62 回応用物理学学会学術講演会, 14p-N-3. 予稿集 No. 1, pp. 296.
  28. 赤坂哲也, 安藤精後, 西田敏夫, 小林直樹, “SiC 段差基板上のクラックフリーGaInおよびAlGaIn厚膜のMOVPE成長”, 2001 年秋季第 62 回応用物理学学会学術講演会, 11a-N-7. 予稿集 No. 1, pp. 246.
  29. 赤坂哲也, 安藤精後, 西田敏夫, 斎藤 正, 小林直樹, “Mg の選択的取り込みによる電流狭窄型マイクロファセットレーザ”, 2002 年春季第 49 回応用物理学関連連合講演会,

29a-ZM-16. 予稿集 No. 1, pp. 386.

30. 赤坂哲也, 安藤精後, 西田敏夫, 小林直樹, “斜め成長外部ミラーを有する面発光型 InGaN マイクロファセットレーザ”, 2002 年秋季 63 回応用物理学会学術講演会, 27a-YH-9. 予稿集 No.1, pp. 348.
31. 俵毅彦, 後藤秀樹, 熊谷雅美, 赤坂哲也, 小林直樹, 齊藤 正, “III-N 系フォトニック結晶による微小共振器の作製と評価”, 2002 年秋季 63 回応用物理学会学術講演会, 24p-YA-11.
32. 赤坂哲也, 西田敏夫, 谷保芳孝, 嘉数 誠, 小林直樹, “高濃度 Si ドープ AlN 中間層による AlGaIn の高品質化”, 2003 年春季第 50 回応用物理学関連連合講演会, 予稿集, 28p-V-7. 予稿集 No.1, pp. 403.
33. 俵毅彦, 後藤秀樹, 赤坂哲也, 小林直樹, 齊藤 正, “III-N 系 1 次元共振器によるモード分裂の観測” 2003 年春季第 50 回応用物理学関連連合講演会, 29p-YN-1. 予稿集 No.3, pp. 1139.
34. 赤坂哲也, 谷保芳孝, 嘉数誠, 西田敏夫, 牧本俊樹, “Si-AlN ナノディスク構造によるクラックフリー AlGaIn の低転位化”, 2003 年秋季第 64 回応用物理学会学術講演会, 30a-F-4.
35. 俵 毅彦, 後藤秀樹, 赤坂哲也, 小林直樹, 齊藤 正, “1 次元 InGaIn 微小共振器の光子一励起子弱結合領域における光学特性”, 2003 年秋季第 64 回応用物理学会学術講演会, 31p-ZM-4.
36. 赤坂哲也, 西田敏夫, 牧本俊樹, “InGaIn 光ガイド構造による InGaIn 系発光素子の発光効率の増大”, 2004 年春季第 51 回応用物理学関連連合講演会, 30a-YN-10.
37. 俵 毅彦, 後藤秀樹, 赤坂哲也, 牧本俊樹, 齊藤 正, “窒化物半導体微小共振器における強結合状態の励起子数依存性”, 2004 年春季第 51 回応用物理学関連連合講演会, 30p-P-18.
38. 赤坂哲也, 後藤秀樹, 中野秀俊, 牧本俊樹, “InGaIn 下地層を用いた InGaIn 多重量子井戸の PL 発光寿命”, 2004 年秋季第 65 回応用物理学会学術講演会, 3p-W-14.
39. 俵 毅彦, 後藤秀樹, 赤坂哲也, 牧本俊樹, 齊藤 正, “InGaIn 共振器ポラリトンの発光特性”, 2004 年秋季第 65 回応用物理学会学術講演会, 2p-ZC-2.
40. 赤坂哲也, 牧本俊樹, “B 系窒化物半導体の流量変調エピタキシー”, 2005 年春季第 52 回応用物理学関連連合講演会, 31a-L-13.
41. 俵 毅彦, 後藤秀樹, 鎌田英彦, 赤坂哲也, 牧本俊樹, 中野秀俊, “InGaIn 共振器ポラリトンの角度分解 PL 測定”, 2005 年春季第 52 回応用物理学関連連合講演会, 31a-YV-10.
42. 赤坂哲也, 後藤秀樹, 中野秀俊, 牧本俊樹, “ポテンシャル揺らぎの少ない InGaIn 量子井戸”, 2005 年秋季第 66 回応用物理学会学術講演会, 11p-X-4.
43. 赤坂哲也, 牧本俊樹, “AlN/AlGaIn 超格子バッファを用いた Si(111)基板上の GaIn 成長”, 2005 年秋季第 66 回応用物理学会学術講演会, 7p-X-8.
44. 俵 毅彦, 後藤秀樹, 鎌田英彦, 赤坂哲也, 牧本俊樹, 中野秀俊, “InGaIn 共振器における励起子一光子強結合状態の時間分解 PL 測定”, 2005 年秋季第 66 回応用物理学会学術講演会, 9a-H-8.
45. 後藤秀樹, 赤坂哲也, 俵 毅彦, 小林康之, 牧本俊樹, 中野秀俊, “InGaIn 量子井戸構造

- における局在励起子からの発光観測”，2005 年秋季第 66 回応用物理学学会学術講演会，11p-X-5.
46. 西川 敦，熊倉一英，赤坂哲也，牧本俊樹，“ $n^+$ -SiC 基板上 p-InGaN/n-GaN 縦型伝導ダイオード”，2005 年秋季第 66 回応用物理学学会学術講演会，8p-W-11.
  47. 赤坂哲也，牧本俊樹，“BGaN micro-islands を用いたサファイア基板上の低転位 GaN 成長”，2006 年春季第 53 回応用物理学関連連合講演会，22a-ZF-3.
  48. 赤坂哲也，小林康之，村木康二，平山祥郎，牧本俊樹，“BGaN micro-islands を用いて成長した GaN および AlGaIn/GaN ヘテロ構造の電気的特性”，2006 年春季第 53 回応用物理学関連連合講演会，22a-ZF-4.
  49. 後藤秀樹，赤坂哲也，俵 毅彦，小林康之，牧本俊樹，中野秀俊，“サファイア基板上に成長した InGaIn 量子井戸構造の局在励起子からの発光観測”，2006 年春季第 53 回応用物理学関連連合講演会，25a-ZL-10.
  50. 西川 敦，熊倉一英，赤坂哲也，牧本俊樹，“窒化物半導体縦型伝導 p-n 接合ダイオードにおける AlGaIn 層の絶縁破壊電界”，2006 年春季第 53 回応用物理学関連連合講演会，25a-ZE-5.
  51. 西川 敦，熊倉一英，赤坂哲也，牧本俊樹，“n 型 6H-SiC 基板上窒化物半導体縦型伝導デバイスのための低抵抗バッファ層 ”，2006 年春季第 53 回応用物理学関連連合講演会，23a-ZE-4.
  52. 中村知弘，小林康之，赤坂哲也，牧本俊樹，松本信雄，“FME 法による Ni(111)基板上六方晶 BN の構造評価 ”，2006 年春季第 53 回応用物理学関連連合講演会，22a-ZQ-5.
  53. 赤坂哲也，小林康之，牧本俊樹，“流量変調エピタキシーを用いた非極性(11-20)および(1-100)面 AlN 薄膜の成長”，2006 年秋季第 67 回応用物理学学会学術講演会，30p-E-8.
  54. 後藤秀樹，赤坂哲也，俵毅彦，小林康之，牧本俊樹，中野秀俊，“レーザ構造中の InGaIn 量子井戸構造における局在励起子の発光特性”，2006 年秋季第 67 回応用物理学学会学術講演会，30p-C-15.
  55. 小林康之，中村知弘，赤坂哲也，牧本俊樹，松本信雄，“FME 法による六方晶 BN ヘテロエピタキシャル成長層の紫外発光特性 ”，2006 年秋季第 67 回応用物理学学会学術講演会，30p-E-12.
  56. 赤坂哲也，小林康之，牧本俊樹，“流量変調エピタキシーを用いた非極性(11-20)および(1-100)面 AlBN 薄膜の成長”，2007 年春季第 54 回応用物理学関連連合講演会，29a-ZM-5.
  57. 小林康之，日比野浩樹，中村知弘，赤坂哲也，牧本俊樹，松本信雄，“グラファイト化した 6H-SiC 基板上 BN 薄膜の MOVPE 成長”，2007 年春季第 54 回応用物理学関連連合講演会，27a-ZM-6.
  58. 赤坂哲也，小林康之，牧本俊樹，“SiC(11-20)基板上に成長した a 面 AlGaIn および AlBN 薄膜の格子定数の評価”，2007 年秋季第 68 回応用物理学学会学術講演会，7p-ZS-13.
  59. 小林康之，日比野浩樹，赤坂哲也，牧本俊樹，“エピタキシャルグラフェン層上の六方晶 BN 薄膜 MOVPE 成長”，2007 年秋季第 68 回応用物理学学会学術講演会，7p-ZS-14.
  60. Chiun-Lung Tsai，小林康之，赤坂哲也，嘉数 誠，“MBE 法による Ni(111)基板上六方晶 BN 成長”，2008 年春季第 55 回応用物理学関連連合講演会，28p-B-2.

61. 小林康之, 赤坂哲也, “サファイア基板上六方晶 BN 薄膜 MOVPE 成長”, 2008 年春季第 55 回応用物理学関連連合講演会, 28a-B-11.
62. 赤坂哲也, 小林康之, 嘉数誠, “SiC(11-20)基板上に成長した a 面 Al<sub>1-x</sub>B<sub>x</sub>N (x<0.01)薄膜の面内歪の異方性”, 2008 年秋季第 69 回応用物理学会学術講演会, 3p-CG-11.
63. Chiun-Lung Tsai, 小林康之, 赤坂哲也, 嘉数誠, “MBE 法により Ni(111)基板上に成長した六方晶 BN のバンド端近傍発光”, 2008 年秋季第 69 回応用物理学会学術講演会, 4p-CA-12.
64. 宮本瑞琴, 小林康之, 赤坂哲也, 松本信雄, 嘉数誠, “サファイア基板上 MOVPE 成長 BN の透過特性” 2008 年秋季第 69 回応用物理学会学術講演会, 4p-CA-11.
65. 赤坂哲也, 小林康之, 嘉数誠, “極性面および非極性面 AlBN 薄膜のエピタキシャル成長”, 2008 年第 22 回ダイヤモンドシンポジウム講演要旨集, pp.86.
66. 小林康之, 赤坂哲也, “サファイア基板上 MOVPE 成長 BN の透過特性”, 2008 年第 22 回ダイヤモンドシンポジウム講演要旨集, pp.18.
67. 赤坂哲也, Jocelyn Achard, 嘉数誠, “ダイヤモンド薄膜の横方向エピタキシャル成長”, 2009 年春季第 56 回応用物理学関連連合講演会, 31p-TC-4
68. 赤坂哲也, 小林康之, 嘉数誠, “MOVPE 選択成長法で作製したステップフリーGaN”, 2009 年春季第 56 回応用物理学関連連合講演会, 31a-ZJ-17.
69. Chiun-Lung Tsai, 小林康之, 赤坂哲也, 嘉数誠, “Ni(111)基板上プラズマ支援 MBE 成長 h-BN の PL スペクトルの温度依存性”, 2009 年春季第 56 回応用物理学関連連合講演会, 30p-ZJ-2.
70. 小林康之, Chiun-Lung Tsai, 赤坂哲也, “低温成長 h-BN バッファ層上の FME 法による h-BN エピタキシャル成長”, 2009 年春季第 56 回応用物理学関連連合講演会, 30p-ZJ-1.
71. 赤坂哲也, 小林康之, 嘉数誠, “数十 μm の GaN ステップフリー面の形成および成長機構の検討”, 2009 年秋季第 70 回応用物理学会学術講演会, 11a-E-6.
72. Chiun-Lung Tsai, 小林康之, 赤坂哲也, 嘉数誠, “Ni(111)基板上 MBE 成長 h-BN の PL の励起密度依存性”, 2009 年秋季第 70 回応用物理学会学術講演会, 8p-J-17.
73. 小林康之, Chiun-Lung Tsai, 赤坂哲也, “バッファ層を用いたサファイア基板上 h-BN エピタキシャル薄膜の FME 成長”, 2009 年秋季第 70 回応用物理学会学術講演会, 8p-J-16.
74. 赤坂哲也, 小林康之, 嘉数誠, “MOVPE 選択成長で作製したステップフリーGaN 薄膜”, 第 1 回窒化物半導体結晶成長講演会 FRI\_01.
75. 赤坂哲也, 小林康之, 嘉数誠, “GaN 薄膜のスパイラルおよび核成長速度の過飽和度依存性”, 2010 年春季第 57 回応用物理学関連連合講演会, 18a-TA-4.
76. 小林康之, 赤坂哲也, “サファイア基板上 Si ドープ BN の FME 成長”, 2010 年春季第 57 回応用物理学関連連合講演会, 18p-TC-1.
77. 赤坂哲也, 小林康之, 嘉数誠, “MOVPE における GaN スパイラルおよび核成長速度の基板温度依存性評価”, 2010 年秋季第 71 回応用物理学会学術講演会, 15p-C-6.
78. 赤坂哲也, 小林康之, 嘉数誠, “窒化ガリウムのステップフリー面の作製と成長機構”, 真空・表面科学合同講演会, 4Ca-06.

79. 赤坂哲也, 小林康之, 嘉数誠, “GaN の MOVPE 成長における表面過飽和度に及ぼすキャリアガスの影響”, 2011 年春季第 58 回応用物理学関係連合講演会, 26a-BY-5.
80. 赤坂哲也, 小林康之, “MOVPE 選択成長による GaN ステップフリー面上への InN 核生成”, 2011 年秋季 第 72 回 応用物理学会学術講演会, 31p-ZE-15.
81. 赤坂哲也, 後藤秀樹, 小林康之, 山本秀樹, “Step-free 界面を有する InN/GaN 単一量子井戸からの紫色狭線発光”, 2012 年秋季 第 73 回 応用物理学会学術講演会, 13a-H9-9.
82. 林家弘, 赤坂哲也, 山本秀樹, “Nucleus and Spiral Growth of N-face GaN (000-1) Obtained by Selective-Area Metalorganic Vapor Phase Epitaxy”, 2012 年秋季 第 73 回 応用物理学会学術講演会, 12p-H9-5.
83. 小林康之, 熊倉一英, 赤坂哲也, 山本秀樹, 牧本俊樹, “GaN 系デバイスの機械的転写のための剥離層としての層状窒化ホウ素”, 2012 年秋季 第 73 回 応用物理学会学術講演会, 14p-H10-8.
84. 小林康之, 熊倉一英, 赤坂哲也, 山本秀樹, 牧本俊樹, “層状窒化ホウ素を剥離層とする GaN 系デバイスの機械的転写法の開発”, 電子情報通信学会電子デバイス研究会, 11 月 29 日~30 日, ED2012-66, 大阪市立大学, 大阪 (2012).
85. 林家弘, 赤坂哲也, 山本秀樹, “螺旋成長した N 極性 GaN (000-1) のらせん転位近傍の TEM 観察”, 2013 年春季 第 60 回 応用物理学会春季学術講演会, 27p-G21-16.
86. 林家弘, 赤坂哲也, 山本秀樹, “InGaN 下地層による(000-1)InGaN 多層量子井戸発光効率の改善”, 2013 年春季 第 60 回 応用物理学会春季学術講演会, 27p-G21-17.
87. 小林康之, 熊倉一英, 赤坂哲也, 山本秀樹, 牧本俊樹, “AlN/BN/AlN ダブルヘテロ構造上の GaN 薄膜の MOVPE 成長”, 2013 年春季 第 60 回 応用物理学会春季学術講演会, 29a-G21-2.
88. 廣木正伸, 熊倉一英, 小林康之, 赤坂哲也, 山本秀樹, 牧本俊樹, “MeTRé 法剥離による極薄 GaN 系素子の作製”, 2013 年春季 第 60 回 応用物理学会春季学術講演会, 29a-G21-19.
89. 赤坂哲也, Andrew Berry, Chiahung Lin, 山本秀樹, “III 族原料間欠導入による 1~2 分子層 InN 単一量子井戸の MOVPE 選択成長”, 2013 年秋季 第 74 回 応用物理学会秋季学術講演会, 19a-B5-8, 京都 (2013).
90. 林家弘, 赤坂哲也, 山本秀樹, “III 族原料流量変調エピタキシーによる N-face GaN(000-1) 成長”, 2013 年秋季 第 74 回 応用物理学会秋季学術講演会, 19a-B5-5, 京都 (2013).
91. 廣木正伸, 熊倉一英, 小林康之, 赤坂哲也, 山本秀樹, 牧本俊樹, “層状 BN 剥離層を用いた AlGaIn/GaN HEMT の銅板への転写”, 2013 年秋季 第 74 回 応用物理学会秋季学術講演会, 19p-D7-14, 京都 (2013).
92. 林家弘, 赤坂哲也, 山本秀樹, “III 族原料流量変調エピタキシーによる N-face GaN(000-1) 選択成長”, 2014 年春季 第 61 回 応用物理学会春季学術講演会, 18a-E13-11, 相模原 (2013.3).
93. 赤坂哲也, 林家弘, 山本秀樹, “III 族原料流量変調エピタキシーによるヒルロックフリー窒素極性 GaN(000-1) 薄膜の成長”, 2014 年秋季 第 75 回 応用物理学会秋季学術講演会, 19p-C5-3, 札幌 (2014.9).

94. 赤坂哲也, 林家弘, 山本秀樹, “III 族原料流量変調エピタキシによる窒素極性 GaN(000-1) 薄膜成長機構”, 2015 年春季 第 62 回 応用物理学会春季学術講演会, 14a-B1-5, 平塚 (2015.3).
95. 赤坂哲也, 林家弘, 山本秀樹, “MOVPE 法による窒素極性(000-1)面 InN/GaN ダブルヘテロ構造の作製” 2016 年春季 第 63 回 応用物理学会春季学術講演会, 22a-H121-10, 東京 (2016.3).
96. 西中淳一, 谷保芳孝, 赤坂哲也, 熊倉一英, ”無極性 m 面 AlN 基板上への AlN の流量変調エピタキシ”, 2016 年春季 第 63 回 応用物理学会春季学術講演会, 22a-H121-7, 東京 (2016.3).
97. 小村一樹, 荒浪誠生, 荒木努, 名西やすし, 赤坂哲也, ”C-AFM によるスパイラル成長した GaN の極微領域評価”, 2016 年春季 第 63 回 応用物理学会春季学術講演会, 20p-H121-12, 東京 (2016.3).
98. 赤坂哲也, Monika Schied, 熊倉一英, “窒素極性 InN(000-1)薄膜結晶性の MOVPE 成長温度依存性”, 2016 年秋季 第 77 回 応用物理学会秋季学術講演会, 16a-P5-9, 新潟 (2016.9).
99. S. Sergent, M. Takiguchi, A. Yokoo, H. Taniyama, A. Shinya, E. Kuramochi, T. Tsuchizawa, T. Akasaka, and M. Notomi, "Fabrication and Optical Properties of ZnO-nanowire-induced nanocavities in grooved SiN photonic crystals", 2016 年秋季 第 77 回 応用物理学会秋季学術講演会, 15p-B4-19, 新潟 (2016.9).